

КТ339АМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты.

Транзисторы КТ339А выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами - КТ-1-12.

Транзисторы КТ339АМ выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами - КТ-26.

Тип приборов указывается на корпусе и в этикетке.

Масса транзистора в металlostеклянном корпусе не более 0,4 г, в пластмассовом корпусе не более 0,3 г.

Технические характеристики транзисторов КТ339А, КТ339АМ:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						$T_{п\text{ max}}$	$T_{\text{ max}}$			
		$I_{к\text{ max}}$	$I_{к. и. \text{ max}}$	$U_{кэ0\text{ max}}$	$U_{кб0\text{ max}}$	$U_{эб0\text{ max}}$	$P_{к\text{ max}}$ ($P_{к. и. \text{ max}}$)	$h_{21\text{ э}}$	$U_{к\text{ на с.}}$	$I_{кб0}$	$f_{гр. (f_{h21})}$	$K_{ш}$	$C_{к}$			$C_{э}$	$T_{п\text{ max}}$	$T_{\text{ max}}$
		мА	мА	В	В	В	мВт		В	мкА	МГц	дБ	пФ			пФ	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
КТ339А	n-p-n	25	-	25	40	4	260	25	-	1	300	-	2	-	175	- 60...+125		
КТ339АМ	n-p-n	25	-	25	40	4	260	25	-	1	300	-	2	-	175	- 60...+125		

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- $I_{к\text{ max}}$ - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- $I_{к. и. \text{ max}}$ - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- $U_{кэR\text{ max}}$ - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- $U_{кэ0\text{ max}}$ - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- $U_{кб0\text{ max}}$ - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- $U_{эб0\text{ max}}$ - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- $P_{к\text{ max}}$ - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- $P_{к. и. \text{ max}}$ - максимально допустимая импульсная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- $h_{21\text{ Э}}$ - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- $h_{21\text{ э}}$ - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в

схеме с общим эмиттером.

- $U_{кэ\text{ нас.}}$ - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- $I_{кбо}$ - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- $f_{гр}$ - граничная частота коэффициента передачи тока.
- f_{h21} - предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
- $Kш$ - коэффициент шума транзистора.
- $C_{к}$ - емкость коллекторного перехода.
- $C_{э}$ - емкость коллекторного перехода.
- $T_{п\text{ max}}$ - максимально допустимая температура перехода.
- $T_{\text{ max}}$ - максимально допустимая температура окружающей среды.